



FACULTY OF PHYSICS AND MATHEMATICS



S.N.F Razzokov Alijon Shonazarovich

Deegre The faculty of Techer

Phone +998919999100

E – mail: razzokov.a@bk.ru

Organization of phone +99862 2246700

Organization of Address: Urganch city Xamid Olimjon street home 14. 220100

LEVEL

- 2004-2008 Urgench State University
- 1996–1998 Institute of Physics and Technology of the Uzbek Academy of Sciences (postgraduate study)
- 1987-1992 Urgench State University

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

- 2017 y. - p .t. – Assistant professor of the department “Physics”, faculty of Physics and Matematics of Urgench State University.
- 2014–2017 y.- Teacher of mathematics at the academic lyceum specialized on military and and juristic direction in Urgench city.
- 2010–2012 y.- The head of administration of secondary-special and professional education in Khorezm.
- 2009–2010 y.- The head of department of expluataion of modern information technologies,administration of the monitoring of the preparation of personnel and application of their labour, Centre of secondary-special and professional education, Ministry of higher and secondary-special education.
- 2008–2009 y.- Deputy chief of administration of the monitoring of the preparation of personnel and application of their labour, Centre of secondary-special and professional education, Ministry of higher and secondary-special education.
- 2007–2008 y.- Director of academic lyceum-1 under

	<p>Tashkent University of Information Technologies Urgench branch</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006–2007 y.- Head of department of academic management of education training processes, administration of secondary-special and professional education of Khorezm. • 2005–2006 y.- Head of department of the personnel and marketing, administration of secondary-special and professional education of Khorezm, deputy chief in supervision at the administration of secondary-special and professional education of Khorezm. • 2002–2005 y.- Deputy chief of the administration of secondary-special and professional education of Khorezm, head of reference group. • 1999–2002 y.- Doctoral candidate at the Institute of Physics and Technology, Academy of Science of Uzbekistan • 1998–1999 y.- Assistant of the scientific laboratory”Crystal growth” Institute of Physics and Technology, Academy of Science of Uzbekistan. • 1996–1998 y.- Postgraduate student of the Institute of Physics and Technology, Academy of Science of Uzbekistan. • 1994–1996 y.- Assistant teacher of the department of “Physics” at Urgench State University. • 1993–1994 y.- Research trinee of the department of “Physics” at Urgench State University. • 1992–1993 y.- Teacher of Physics at general secondary school-1 in Yangiariq town.
SPECIALIZATION	<ul style="list-style-type: none"> • Physics and mathematics, economics (microeconomics)
TEACHING SUBJECTS:	<ul style="list-style-type: none"> • Holography, theoretical mechanics, molecular physics, general physics, biophysics
RESEARCH WORK	<ul style="list-style-type: none"> • Obtaining and research of electrophysical, photoelectric properties of semiconductor solid solutions of SiGe, (GaAs) (ZnSe), (Si) (GaP) from solid phase

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

- Certificate 28, received at the professional development centre in Mannheim, the Federal Republic of Germany, April-May, 2007.
- Certificate 258, received at the professional development centre in Berlin, the Federal Republic of Germany, June, 2009.
- Certificate 1203, received at the institute of the professional development and retraining of pedagogues under Secondary-special and Professional Education Centre, February, 2002.
- Centre of secondary-special and professional education, “Professional education in the sphere of ICT, based on the needs of the labour market”, 2010.
- “Development of human resources” educational course, Centre of Education Development in the sphere of Foreign Economic Affairs, Ministry of Foreign Economic Affairs, 2006.
- Professional development in “DEDEMAN”, “Uzbekistan and Global Market”, 2008.
- А.С.Саидов, А.Ш.Раззоков. Получение и морфологические исследования эпитаксиальных слоев твердого раствора $Si_{1-x}Ge_x$; Сибирский физический журнал. Новосибирск, 2020. Том 15, №2, стр.84-90;
- А.С.Саидов, А.Ш.Раззоков, Кошчанова Д.Э. Каттик аралашмали яримўтказгич материалларни суюк фазадан ўстириб олишнинг назарий асослари.; Урганч, Илм сарчашмалари, 2020 №3 стр. 14-19.;
- Саидов.А.С, Раззоков А.Ш, Исмаилов.Ш.К, Асатова.У.П Жидкофазная эпитакция твердых растворов растворов $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ и $(GaAs)_{1-x-y}(Ge_2)(ZnSe)_y$; “ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРИЯ” Международный научный журнал №2.1/2017.;
- А.Ш.Раззоков, А.Р.Матназаров, М.А.Латипова, А.И.Жапаков. Физико-химические основы выращивания варизонного полупроводникового $Si_{1-x}Ge_x$ твердого раствора из жидкой фазы; Научный журнал «Бюллетень науки и практики» том 6, №9, 2020, Стр. 10-17.
- A.S.Saidov, A.Sh.Razzokov, Sh/K.Ismoilov, U.P.Asatova Liquid-phase epitaxy of solid solutions $(Ge)_{1-x}(In)_x$ and

$(\text{GaAs})_{1-x-y}(\text{ZnSe})_x$; Республиканская научная конференции “СПФКС-2016” Бухоро-2016. Стр. 176.

- Саидов А.С., Раззоков А.Ш., Сапаров Д.В. «О ширине запрещенной зоны полупроводников»; Международная конференция «Актуальные проблемы молекулярной спектроскопии конденсированных сред. Самарканд, 22-24 сентября 2016 г.
- А.С. Саидов, А.Ш.Раззоков, Д.В.Сапаров «Закономерности образования запрещенной зоны полупроводников»; Республиканская конференция «Возобновляемой источники энергии: технологии и установки». Ташкент, 14-15 июня 2016 г.
- Saidov A.S., Saparov D.V., Usmanova S.S., Razzokov A.Sh. «The influence of the nanosized crystals on the spectral photosensitivity of the $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ heterostructure»; New Trends of Development Fundamental and Applied Physics: Problems, Achievements and Prospects, 10-11 November 2016, Tashkent, Uzbekistan.
- Саидов А.С., Сапаров Д.В., Раззоков А. «Температурная зависимость вольтамперной характеристики $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ гетероструктуры».; Международная конференция. «Фундаментальные и прикладные вопросы физики», Ташкент, 13-14 июнь. 2017, стр. 180-181.
- Сапаров Д.В.Саидов А.С, Раззоков А. Ш., Кутлимуратов Б.Р. «Спектральная чувствительность $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ гетероструктур». ; Республиканская научная конференция «Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых структурах» 1-2 февраль. 2017. Ташкент.
- Раззоков А. Ш., Юлдашева Г.Г. Лаборатория машғулотларидаги зарурий назарий ва амалий билимлар; “Актуальные вызовы современной науки” XXVI Международная научная конференция 26-27 июня 2018 г. Украина, вып. 6(26), стр. 136-140.
- Саидов А.С., Сапаров Д.В., Раззоков А. Ш. «Получение и фотолюминесценция варизонного твердого раствора $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ с нанокристаллами»; Материалы Республиканской конференции «Роль одаренной молодежи в развитии физики» Национальный Университет Узбекистана. Тошкент. 18 май 2019.;

- А.Ш.Раззоков, Д.Ш.Курбанов. Зависимость дислокаций на твердом растворе $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ от температур роста на контактной фазе «Твердое тело-жидкость»; РИАК-ХШ. Ташкент 2020 г. Стр 275-277.
- А.Ш.Раззоков, Д.Э.Кошчанова Температурная зависимость растворимости германия в жидких металлах с учетом их обобщенных моментов; РИАК-ХШ. Ташкент 2020 г. Стр 313-316.
- А.Ш.Раззоков, Д.Ш.Курбанов. Получения полупроводниковых твердых растворов на основе кремния и германия; “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами 22-23 сентябр Қарши-2020, стр. 98-99.
- А.Ш.Раззоков, Д.Э.Кошчанова. $(\text{C}_{2}^{\text{VI}})_{1-x}(\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}})_x, (\text{C}_{2}^{\text{VI}})_{1-x}(\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}})_x$ ва бошқа синфларга оид яримўтказгич эпитаксиал қатламларини олишнинг илмий башорат асослари; “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами 22-23 сентябр Қарши-2020, бет. 266-267.
- Раззоков А.Ш., Хакимов Н.З, Давлетов И.Ю., Вапаев М.Э.Новый подход для расчета «Потенциала многоэлектронного атома»; Материалы V Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах. 13-14 ноября 2020 года Фергана. стр. 322-324.
- Раззоков А.Ш., Хакимов Н.З., Давлетов И.Ю., Эшчонов Х.О., Матназаров А.Р.Получение структурно совершенного полупроводникового твердого раствора $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ с заданными электрофизическими и фотоэлектрическими свойствами; Материалы V Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах. 13-14 ноября 2020 года Фергана. стр. 324-327.
- Razzokov A.Sh., Khakimov N.Z, Davletov I.Y., Eshchanov Kh.O., Matnazarov A.R. OBTAINING A STRUCTURALLY PERFECT SEMICONDUCTOR SOLID SOLUTION $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ WITH SPECIFIED ELECTROPHYSICAL AND PHOTOELECTRIC

	PROPERTIES Scientific-technical journal 2020, V.24, №5. pp 51-60
CURRENT RESEARCH	<ul style="list-style-type: none">• Razzakov A. Sh., Latipova M. A., Kadirov A. X. Obtaining varizonnogo solid solid solution Si1 – xGex from solid phase // Bulletin of science and practice. 2021. T. 7. №3. S. 200-205. https://doi.org/10.33619/2414-2948/64/20 Cite